

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 6 部門第 4 区分
 【発行日】平成 17 年 5 月 12 日 (2005.5.12)

【公開番号】特開 2003-59258 (P2003-59258A)
 【公開日】平成 15 年 2 月 28 日 (2003.2.28)
 【出願番号】特願 2002-207874 (P2002-207874)
 【国際特許分類第 7 版】
 G 1 1 C 11/15
 【F I】
 G 1 1 C 11/15 1 5 0

【手続補正書】
 【提出日】平成 16 年 6 月 30 日 (2004.6.30)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】明細書
 【補正対象項目名】特許請求の範囲
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

メモリアレイ (100) を読み出す方法であって、前記メモリアレイ (100) が複数のワード線 (110) と複数のビット線 (120) とを含み、前記ワード線および前記ビット線が複数のメモリセル (130) において交差し、その方法が、

選択されたメモリセル (130) に結合される選択されたワード線 (110) に読出し電圧 (V_r) を印加するステップと、

前記選択されたメモリセルに結合される選択されたビット線 (120) を、第 1 のスイッチ (301~308) を介して基準電圧に結合するステップと、

前記選択されたメモリセルを、第 2 のスイッチ (400~408) を介してセンシング装置 (700) に結合するステップと、

前記選択されたメモリセルを前記基準電圧から切り離すために、前記第 1 のスイッチ (301~308) を開くステップと、及び

前記センシング装置を用いて、前記選択されたメモリセルの 2 値状態を読み出すステップとからなる、方法。

【請求項 2】

前記第 1 および前記第 2 のスイッチが、前記選択されたビット線の端部に結合され、前記第 1 のスイッチを開くステップが、

前記選択されたメモリセルを前記センシング装置に結合するステップの後に、前記第 1 のスイッチを開くことを含む、請求項 1 に記載の方法。

【請求項 3】

前記第 1 のスイッチを開くステップが、

前記選択されたメモリセルの 2 値状態を読み出すステップの前に、前記第 1 のスイッチを開くことを含む、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 4】

前記メモリセルの 2 値状態を読み出すステップの後に、前記第 1 のスイッチを閉じることを含む、請求項 3 に記載の方法。

【請求項 5】

前記メモリセルの 2 値状態を読み出すステップの後に、前記第 2 のスイッチを開くことを含む、請求項 4 に記載の方法。

【請求項 6】

選択されたワード線に読出し電圧を印加するステップが、
前記選択されたワード線に前記読出し電圧を結合するスイッチを閉じることを含む、請
求項 5 に記載の方法。

【請求項 7】

前記選択されたメモリセルをセンシング装置に結合するステップが、
前記選択されたビット線を前記基準電圧に結合することを含む、請求項 6 に記載の方法
。

【請求項 8】

前記基準電圧がグラウンド電位である、請求項 7 に記載の方法。

【請求項 9】

前記選択されたビット線の端部の電位は、前記選択されたメモリセルが前記センシング
装置に結合される際に実質的に変化しない、請求項 2 に記載の方法。

【請求項 10】

前記基準電圧がグラウンド電位である、請求項 9 に記載の方法。